

講演分科日程表 (分科別) I

山形大学

| 大分類分科名 中分類分科名 | 8月29日(月) | | 8月30日(火) | | 8月31日(水) | | 9月1日(木) | | 9月2日(金) | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|
| | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 本部共通行事 | | | | | | | | | | |
| 平成 23 年度秋季評議員・代議員合同会議 | | | | 理先端-C 25 15:30 ~ 16:30 | | | | | | |
| 第 33 回応用物理学会「論文賞」授賞式 | | | | 理先端-C 25 16:30 ~ 17:10 | | | | | | |
| 応用物理学会第 5 回(2011 年度)フェロー表彰式 | | | | 理先端-C 25 17:10 ~ 17:40 | | | | | | |
| 「女性研究者奨励育成貢献賞(小館賞)」授賞式 | | | | 理先端-C 25 17:40 ~ 18:00 | | | | | | |
| 特別シンポジウム 「有機 EL 研究開発 25 年: これまでとこれから」 | 基盤 2-ZF 16 9:20 ~ 18:00 | | | | | | | | | |
| 超伝導分科会・応用物理学会東北支部共同企画 超伝導 100 周年特別シンポジウム 「100 年の歴史に学ぶ超伝導~新たな 100 年の発展に向けて~」 | | | 文翔-YB 17 9:00 ~ 16:55 | | | | | | | |
| 人財育成・教育事業委員会 若手・人財育成/男女共同参画部門合同企画ミーティング「若手・女性研究者のネットワーク構築 - 事例から実践へ -」 | | | | | | 基盤 1-135 18 16:30 ~ 18:30 | | | | |
| APEX/JJAP フレンドシップミーティング 「注目! APEX の Impact Factor は?」 | | | | | | 地域 3-E 19 16:00 ~ 18:00 | | | | |
| 博士のキャリア相談会 | | | | | 大学会館 20 11:30 ~ 16:00 | | | | | |
| 第 49 回応用物理学会スクール 「スピントロニクス、これまでの 20 年、これからの 20 年」 | 基盤 1-Q 21 8:55 ~ 17:30 | | | | | | | | | |
| 第 48 回応用物理学会スクール 「扇形ナノプロセス入門 - 基礎と将来展望 -」 | 基盤 1-R 22 9:00 ~ 17:20 | | | | | | | | | |
| 第 49 回応用物理学会スクール 「グラフェンの基礎から応用まで」 | | | 基盤 1-N 23 9:25 ~ 17:00 | | | | | | | |
| 第 11 回応用物理学会 業績賞受賞記念講演/ 細野秀雄氏 | 理先端-C 34 15:00 ~ 15:50 | | | | | | | | | |
| 第 11 回応用物理学会 業績賞受賞記念講演/ 辻内順平氏 | 理先端-C 34 16:00 ~ 16:50 | | | | | | | | | |
| 第 12 回光・量子エレクトロニクス 業績賞(花間宏賞) 受賞記念講演/ 渋谷眞人氏 | | | 基盤 3-ZL 58 10:30 ~ 11:05 | | | | | | | |
| 第 12 回光・量子エレクトロニクス 業績賞(花間宏賞) 受賞記念講演/ 香取秀俊氏・高本将男氏 | | | | 基盤 3-ZH 45 15:00 ~ 15:35 | | | | | | |
| 第 8 回光・電子集積技術業績賞 (林敏雄賞) 受賞記念講演/ 中川茂氏 | | | | | | 基盤 3-ZN 49 15:00 ~ 15:35 | | | | |
| 第 1 回化合物半導体エレクトロニクス 業績賞(赤崎勇賞) 受賞記念講演/ 名西徳之氏 | | | 基盤 2-ZE 96 9:00 ~ 9:35 | | | | | | | |
| 第 33 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (優秀論文賞) | | | 基盤 1-L 57 9:30 ~ 10:00 | | | 基盤 1-K 106 15:00 ~ 15:30 | | 基盤 3-ZG 39 15:00 ~ 15:30 | | |
| 第 33 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (論文奨励賞) | | | | 人文-ZR 42 9:40 ~ 10:00 | 基盤 3-ZJ 105 15:00 ~ 15:30 | 基盤 2-ZB 100 12:40 ~ 13:00 | 基盤 3-ZH 101 15:00 ~ 15:20 | | 基盤 1-K 89 15:00 ~ 15:20 | |
| | | | | 人文-ZS 66 11:00 ~ 11:20 | | 人文-ZT 69 12:40 ~ 13:00 | | | 基盤 1-M 63 15:00 ~ 15:30 | |
| 第 33 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (解説論文賞) | | | | | | | 地域 3-F 45 15:00 ~ 15:30 | 人文-ZS 68 9:00 ~ 9:30 | | |
| シリコンテクノロジー分科会論文賞奨励 賞表彰式 | | | | | | | 基盤 1-Q 84 15:00 ~ 15:30 | | | |
| 有機分子バイオ・バイオエレクトロニク ス分科会論文賞・奨励賞受賞記念講演 | | | 基盤 1-Q 77 10:30 ~ 11:00 | | | | | 地域 1-V 80 15:00 ~ 15:30 | | |
| プラズマエレクトロニクス受賞記念講 演 | | | | 基盤 1-L 60 16:15 ~ 17:20 | | | | | | |
| 放射線賞授賞式・受賞記念講演 | 基盤 1-K 36 13:00 ~ 13:30 | | | | | | | | | |
| 懇親会 | | | | 文翔 25 19:00 ~ 20:30 | | | | | | |
| 1. 放射線 | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 1-T 36 13:30 ~ 16:55 | | | | | | | | |
| チュートリアル(ショートコース) | | 地域 1-T 13 15:00 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 1.1 放射線物理一般・検出器基礎 | | | 地域 1-T 37 9:00 ~ 12:45 | 地域 1-T 37 15:00 ~ 16:30 | | | | | | |
| 1.2 検出器開発 | | | | | 地域 1-T** 37 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-T 38 15:00 ~ 16:30 | | | | |
| 1.3 放射線応用・発生装置・新技術 | | | | | | | 地域 1-T 38 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-T 38 15:00 ~ 16:15 | | |
| 2. 計測・制御 | | | | | | | | | | |
| 2.1 計測・制御技術 | | | **理 1-B(ショート) 10:30 ~ 11:45 | →ポスター(第 2) 38 13:00 ~ 15:00 | | | | | | |
| 2.2 精密計測・ナノ計測 | | | 理 1-B 39 11:45 ~ 12:30 | | | | | | | |
| 2.3 計測標準 | | | | | | 基盤 1-J** 39 15:00 ~ 17:45 | | | | |

会場名(アルファベット)の前は、建物を表示
(例: 理 1-B は理学部 1 号館の B 会場)
**分科内招待講演あり
シンポジウムは、12 頁参照。

【建物略称】

| | | | | | |
|------------|---|------|---------------|---|------|
| 理学部 1 号館 | → | 理 1 | 地域教育文化学部 1 号館 | → | 地域 1 |
| 理学部先端科学実験棟 | → | 理先端 | 地域教育文化学部 3 号館 | → | 地域 3 |
| 基盤教育棟 1 号館 | → | 基盤 1 | 人文学部 1 号館 | → | 人文 |
| 基盤教育棟 2 号館 | → | 基盤 2 | 文翔館 | → | 文翔 |
| 基盤教育棟 3 号館 | → | 基盤 3 | 第 1 体育館 | → | 第 1 |
| | | | 第 2 体育館 | → | 第 2 |

講演分科日程表 (分科別) II

山形大学

| 大分類分科名 | 8月29日(月) | | 8月30日(火) | | 8月31日(水) | | 9月1日(木) | | 9月2日(金) | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 中分類分科名 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 3. 光 | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | 基盤2-ZB 35 10:00 ~ 16:40 | | | | | | | | | |
| チュートリアル (ショートコース) | | 基盤1-M 37 13:30 ~ 18:00 | | | | | | | | |
| 3.1 物理光学・光学基礎 | | 地域1-S 13 15:00 ~ 18:40 | | | | | | | 基盤3-ZG*** 39 15:00 ~ 17:15 | |
| 3.2 材料光学 | | | | 基盤3-ZL** 39 15:00 ~ 18:00 | | | | | | |
| 3.3 機器・デバイス光学 | | | | 第1-P12 40 13:00 ~ 15:00 | | | | | | |
| 3.4 計測光学 | | | | | 基盤3-ZL (ショート) 40 10:30 ~ 11:30 | →ポスター (第1) 40 15:30 ~ 17:30 | | | | |
| 3.5 情報光学 | | | | | | 基盤3-ZL 40 15:00 ~ 18:45 | | | | |
| 3.6 生体・医用光学 | | | | | | | 理1-B 40 15:00 ~ 18:15 | 理1-B 41 9:00 ~ 12:00 | 理1-B 41 13:00 ~ 15:00 | |
| 3.7 近接場光学 | | | | 第1-P13 41 13:00 ~ 15:00 | | | | | | |
| 3.8 光学新領域 | | | | | | 基盤3-ZJ 42 15:00 ~ 18:30 | | | | |
| 4. 量子エレクトロニクス | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | 基盤1-N 34 9:00 ~ 18:00 | | | | | | | | | |
| チュートリアル (ショートコース) | | 基盤1-J 13 15:00 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 4.1 量子光学・原子光学 | | | | 人文-ZR* 42 9:40 ~ 13:00 | | | | | | |
| 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | | | | | 人文-ZR 42 10:00 ~ 13:00 | 人文-ZR 43 15:00 ~ 18:30 | 人文-ZR 43 10:00 ~ 13:00 | 人文-ZR 43 15:00 ~ 18:30 | 人文-ZR 43 9:00 ~ 11:30 | |
| 4.3 レーザー装置・材料 | | | 基盤1-J 44 9:00 ~ 13:00 | 基盤1-J 44 15:00 ~ 18:15 | 基盤1-J 44 9:00 ~ 10:45 | | | | | |
| 4.4 超高速・高強度レーザー | | | 基盤3-ZH 44 9:00 ~ 13:00 | 基盤3-ZH# 44*45 15:00 ~ 18:35 | | | | | | |
| 4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 | | | | | 地域3-F 45 9:00 ~ 13:00 | 地域3-F* 45 15:00 ~ 18:15 | 地域3-F 46 9:00 ~ 13:00 | 地域3-F 46 15:00 ~ 18:30 | 地域3-F 46 9:00 ~ 12:00 | 地域3-F 46 13:00 ~ 14:45 |
| 4.6 レーザー分光応用・計測 | | | | | | | | 人文-ZT 47 15:00 ~ 17:00 | | |
| 4.7 レーザー・プロセッシング | | | | | 理1-B 47 9:00 ~ 12:25 | | 理1-B** 47 9:00 ~ 13:00 | | | |
| | | | | | 理1-B (ショート) 47 12:25 ~ 12:57 | →ポスター (第2) 47 15:30 ~ 17:30 | | | | |
| 5. 光エレクトロニクス | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤2-ZD 35 13:00 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 5.1 半導体レーザー・発光/受光素子 | | | | | | | 基盤3-ZL 48 9:45 ~ 13:00 | 基盤3-ZI 48 16:15 ~ 17:30 | 基盤3-ZL 48 15:00 ~ 18:00 | |
| 5.2 光記録/ストレージ | | | | | | | | 基盤3-ZI 48 15:00 ~ 16:00 | | |
| 5.3 光制御 | | | | | 基盤3-ZN 49 9:45 ~ 13:00 | 基盤3-ZN# 49 15:00 ~ 19:00 | 基盤3-ZN 49 9:45 ~ 13:00 | 基盤3-ZN** 49 15:00 ~ 19:00 | 基盤3-ZN** 50 9:00 ~ 12:00 | 基盤3-ZN 50 13:00 ~ 15:00 |
| 5.4 光ファイバー | | | 第1-P3 50 9:30 ~ 11:30 | | | | | | | |
| 6. 薄膜・表面 | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤3-ZH 36 13:30 ~ 17:00 | | | | | | | | |
| 6.1 強誘電体薄膜 | | | | | 理先端-C 50 9:00 ~ 12:30 | 理先端-C 50 15:00 ~ 18:30 | 理先端-C 51 9:00 ~ 12:30 | 理先端-C 51 15:00 ~ 18:45 | | |
| 6.2 カーボン系薄膜 | | | 第1-P1 51 9:30 ~ 11:30 | | | 第1-P4 52 9:30 ~ 11:30 | | | | |
| 6.3 酸化物エレクトロニクス | | | 基盤3-ZK 53 9:00 ~ 13:00 | 基盤3-ZK 53 15:00 ~ 18:15 | 基盤3-ZK 53 9:45 ~ 13:00 | 基盤3-ZK 53 15:00 ~ 19:00 | 基盤3-ZK 54 9:45 ~ 13:00 | 基盤3-ZK 54 15:00 ~ 19:00 | 基盤3-ZK 54 9:00 ~ 13:00 | |
| 6.4 薄膜新材料 | | | 地域3-D 55 9:00 ~ 13:00 | 地域3-D 55 15:00 ~ 18:15 | 地域3-D** 55 9:00 ~ 13:00 | 地域3-D 55 15:00 ~ 16:30 | | | | |
| 6.5 表面物理・真空 | | | | 第1-P14 56 15:30 ~ 17:30 | | | | | | |
| 6.6 プロローブ顕微鏡 | | | 基盤2-ZC 56 9:00 ~ 13:00 | 基盤2-ZC 57 15:00 ~ 17:30 | 基盤2-ZC 57 10:00 ~ 13:00 | 基盤2-ZC 57 15:00 ~ 17:30 | | | | |
| 7. ビーム応用 | | | | | | | | | | |
| 7.1 X線技術 | | | | 理1-B 57 15:00 ~ 17:15 | | | | | | |
| 7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 | | | 基盤1-L* 57 9:30 ~ 12:15 | | | | | | | |
| 7.3 リソグラフィ | | | #基盤3-ZL (ショート) 58 10:30 ~ 11:58 | →ポスター (第1) 58 15:30 ~ 17:30 | | | | | | |
| 7.4 ナノインプリント | | | 基盤3-ZN 58 10:00 ~ 12:45 | 基盤3-ZN 58 15:00 ~ 18:00 | | | | | | |
| 7.5 ビーム・光励起表面反応 | | | | 基盤1-K 59 15:00 ~ 17:00 | | | | | | |
| 7.6 イオンビーム一般 | | | | | | | 理1-A 59 10:00 ~ 12:45 | 理1-A 59 15:00 ~ 17:45 | 理1-A 59 9:00 ~ 11:45 | |
| 7.7 微小電子源 | | | 基盤3-ZM 59 10:00 ~ 13:00 | 基盤3-ZM 60 15:00 ~ 17:45 | | | | | | |
| 7.8 ビーム応用一般・新技術 | | | | 理1-B 60 17:15 ~ 18:00 | | | | | | |

会場名(アルファベット)の前は, 建物を表示
(例: 理1-Bは理学部1号館のB会場)
*応用物理学会論文賞受賞記念講演あり.
**分科内招待講演あり.
●海外研究者招待講演あり.
#光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり.
##光・電子集積技術業績賞受賞記念講演あり.
シンポジウムは, 12頁参照.

【建物略称】
理学部1号館 → 理1
理学部先端科学実験棟 → 理先端
基盤教育棟1号館 → 基盤1
基盤教育棟2号館 → 基盤2
基盤教育棟3号館 → 基盤3
地域教育文化学部1号館 → 地域1
地域教育文化学部3号館 → 地域3
人文学部1号館 → 人文
文翔館 → 文翔
第1体育館 → 第1
第2体育館 → 第2

講演分科日程表 (分科別) III

山形大学

| 大分類分科名 中分類分科名 | 8月29日(月) | | 8月30日(火) | | 8月31日(水) | | 9月1日(木) | | 9月2日(金) | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 8. プラズマエレクトロニクス | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 3-ZN 37 13:35 ~ 17:30 | | | | | | | | |
| 分科内招待講演, PE 賞受賞記念講演 | | | | 基盤 1-L** 60 15:00 ~ 17:20 | | | | | | |
| 8.1 プラズマ生成・制御 | 基盤 3-ZN 60 9:45 ~ 12:30 | | 理 1-A 60 9:00 ~ 12:00 | | | | | | | |
| 8.2 プラズマ診断・計測 | | | | | 基盤 3-ZJ 61 9:00 ~ 13:00 | | | | | |
| 8.3 プラズマ成膜・表面処理 | | | | | | | 基盤 2-ZC(ショート): 10:30 ~ 11:16 | →ポスター(第1) 61 13:00 ~ 15:00 | 基盤 2-ZC(ショート): 11:16 ~ 11:54 | →ポスター(第1) 61 15:30 ~ 17:30 |
| 8.4 プラズマエッチング | | | 基盤 1-M 62 9:00 ~ 13:00 | | 基盤 1-M 62 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-M* 63 15:00 ~ 18:30 | | | | |
| 8.5 プラズマナノテクノロジー | 基盤 3-ZM 63 9:00 ~ 12:45 | | | | | | | | | |
| 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野 | | | 基盤 2-ZD* 63 9:00 ~ 12:45 | | 基盤 2-ZD 63 9:00 ~ 12:45 | 基盤 2-ZD 64 15:00 ~ 17:30 | 基盤 2-ZD 64 10:00 ~ 12:45 | | | |
| 9. 応用物性 | | | | | | | | | | |
| チュートリアル(ショートコース) | | 地域 1-W 13 15:00 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 9.1 誘電材料・誘電体 | | | 第 1-P2 64 9:30 ~ 11:30 | | | | | | | |
| 9.2 微粒子・粉体 | | | 地域 3-F 64 9:00 ~ 9:30 | | | | | | | |
| 9.3 ナノエレクトロニクス | | | | | 基盤 3-ZQ 64 15:30 ~ 18:45 | 基盤 3-ZQ 65 9:45 ~ 13:00 | 基盤 3-ZQ 65 15:00 ~ 18:50 | | | |
| 9.4 熱電変換 | | | 地域 3-F 65 9:35 ~ 13:00 | 地域 3-F 66 15:00 ~ 16:00 | | | | | | |
| 9.5 新機能材料・新物性 | | | | | | | | 基盤 3-ZQ 66 9:00 ~ 11:45 | 基盤 3-ZQ 66 13:00 ~ 14:30 | |
| 10. スピントロニクス・マグネティクス | | | | | | | | | | |
| 10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等) | | | 人文-ZS* 66 9:00 ~ 12:50 | 人文-ZS 66 15:00 ~ 17:45 | | | | | | |
| 10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術 | | | | | 人文-ZS(ショート): 10:30 ~ 11:30 | →ポスター(第1) 67 13:00 ~ 15:00 | | | | |
| 10.3 GMR・TMR・磁気記録技術 | | | | | | | | | 地域 1-S 67 9:00 ~ 12:00 | 地域 1-S 67 13:15 ~ 15:00 |
| 10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス | | | | | | | 地域 1-S 68 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-S 68 15:00 ~ 17:15 | | |
| 11. 超伝導 | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 2-ZA 36 13:00 ~ 17:55 | 文明-YB 34 9:00 ~ 16:55 | | | | | | | |
| 11.1 基礎物性 | | | | | 人文-ZS 68 15:00 ~ 19:00 | 人文-ZS* ** 68 9:00 ~ 13:00 | 人文-ZS 69 15:00 ~ 19:00 | | | |
| 11.2 薄膜・厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 | | | | | 人文-ZT* 69 9:45 ~ 13:00 | 人文-ZT** 69 15:00 ~ 19:00 | 人文-ZT 70 9:30 ~ 13:00 | | | |
| 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用 | | | | | | | 基盤 3-ZI** 70 10:00 ~ 11:45 | | | |
| 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用 | | | | | | | 基盤 3-ZI(ショート): 12:00 ~ 12:34 | →ポスター(第2) 70 13:00 ~ 15:00 | | |
| 11.4 アナログ応用および関連技術 | | | | | 地域 1-W 70 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-W 71 15:00 ~ 17:45 | 地域 1-W 71 9:30 ~ 12:00 | | | |
| 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 | | | | | 基盤 3-ZM 71 9:30 ~ 13:00 | 基盤 3-ZM 71 15:00 ~ 17:45 | 基盤 3-ZM** 72 9:45 ~ 13:00 | | | |
| 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 2-ZF 34 9:20 ~ 18:00 | | | | | | | | |
| 12.1 作製技術 | | | 地域 1-V 72 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-V 72 15:00 ~ 18:15 | 地域 1-V 73 10:15 ~ 13:00 | 地域 1-V 73 15:00 ~ 17:15 | | | | |
| 12.2 評価・基礎物性 | | | | | | | 基盤 2-ZB 73 10:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZB 73 15:00 ~ 19:00 | 基盤 2-ZB 74 9:00 ~ 11:45 | 基盤 2-ZB 74 13:00 ~ 14:15 |
| 12.3 電子機能材料・デバイス | | | | | | | 地域 3-D 74 10:00 ~ 12:45 | 地域 3-D** 74 15:00 ~ 17:30 | | |
| 12.4 光機能材料・デバイス | | | 地域 1-S 74 9:00 ~ 12:45 | 地域 1-S 75 15:00 ~ 17:15 | | | | | | |
| 12.5 液晶 | | | | | 基盤 1-R 75 15:00 ~ 18:30 | | | | | |
| 12.6 高分子・ソフトマテリアル | | | | | | | 地域 3-G 75 9:45 ~ 13:00 | 地域 3-G** 75 15:00 ~ 16:30 | | |
| 12.7 生物・医用工学・バイオチップ | | | 基盤 3-ZG 75 10:00 ~ 13:00 | 基盤 3-ZG 76 15:00 ~ 18:00 | 基盤 3-ZG 76 10:00 ~ 13:00 | 基盤 3-ZG 76 15:00 ~ 18:45 | 基盤 3-ZG 76 10:00 ~ 13:00 | | | |
| 12.8 有機 EL | | | ※ 基盤 1-Q(ショート): 10:30 ~ 12:00 | →ポスター(第2) 77 15:30 ~ 17:30 | | | | | | |
| 12.9 有機トランジスタ | | | 基盤 1-R(ショート): 10:30 ~ 11:02 | →ポスター(第2) 77 13:00 ~ 15:00 | 基盤 1-R(ショート): 10:30 ~ 11:18 | →ポスター(第2) 78 13:00 ~ 15:00 | 基盤 1-R 78 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-R* 79 15:10 ~ 18:45 | 基盤 1-R 79 9:00 ~ 12:00 | |
| 12.10 ナノバイオテクノロジー | | | | | | | 地域 1-V 79 9:00 ~ 13:00 | 地域 1-V** 80 15:00 ~ 19:00 | 地域 1-V 80 9:00 ~ 12:00 | 地域 1-V 80 13:00 ~ 15:00 |
| 12.11 特定テーマ「有機太陽電池」 | | | | | 基盤 1-L 80 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-L** 81 15:00 ~ 19:00 | 基盤 1-L 81 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-L** 81 15:00 ~ 19:00 | 基盤 1-L 81 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-L 82 13:00 ~ 14:30 |
| 12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」 | | | 基盤 3-ZQ 82 9:00 ~ 13:00 | 基盤 3-ZQ 82 15:00 ~ 18:00 | 基盤 3-ZQ 83 10:00 ~ 11:45 | | | | | |

会場名(アルファベット)の前は, 建物を表示
(例: 理 1-Bは理学部 1号館のB会場)

* 応用物理学論文賞受賞記念講演あり。

** 分科内招待講演あり。

● 海外研究者招待講演あり。

※ 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演あり。

※※ 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会論文賞受賞記念講演あり。

シンポジウムは, 12 頁参照。

【建物略称】

理学部 1号館 → 理 1

理学部先端科学実験棟 → 理先端

基盤教育棟 1号館 → 基盤 1

基盤教育棟 2号館 → 基盤 2

基盤教育棟 3号館 → 基盤 3

地域教育文化学部 1号館 → 地域 1

地域教育文化学部 3号館 → 地域 3

人文学部 1号館 → 人文

文翔館 → 文翔

第 1 体育館 → 第 1

第 2 体育館 → 第 2

講演分科日程表について (例)

| 8月29日(月) | | 8月30日(火) | | 8月31日(水) | | 9月1日(木) | | 9月2日(金) | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 理1-B(ショート) 10:30~11:45 | →ポスター 13:00~15:00 | 第1-R 9:30~11:30 | 理1-B 34 9:00~12:00 | 人文-ZR 42 9:00~12:15 | 人文-ZR 42 13:15~17:00 | 地域3-F 40 9:00~12:00 | 地域3-F 40 13:00~14:30 | | |
| amがショート講演, pmがポスターセッションの例 | | ポスターセッションのみ | 場所の略記号(理学部1号館, B会場) | 講演時間 | | プログラム掲載頁 | | | |

講演分科日程表 (分科別) IV

山形大学

| 大分類分科名 中分類分科名 | 8月29日(月) | | 8月30日(火) | | 8月31日(水) | | 9月1日(木) | | 9月2日(金) | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 13. 半導体 A (シリコン) | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | 人文-ZR 34 9:00 ~ 12:00 | 基盤 2-ZC 36 13:30 ~ 16:15 | | | | | | | | |
| チュートリアル (ショートコース) | | 基盤 3-ZM 36 13:30 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 13.1 基礎物性・評価 | | 基盤 3-ZG 13 15:30 ~ 17:00 | | | | | | 基盤 1-J 83 15:00 ~ 18:15 | 基盤 1-J 83 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-J 83 13:00 ~ 14:30 |
| 13.2 半導体表面 | | | 地域 1-W 83 10:00 ~ 13:00 | 地域 1-W 84 15:00 ~ 17:30 | | | | | | |
| 13.3 絶縁膜技術 | | | | | 基盤 1-Q 84 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-Q 84 15:00 ~ 18:50 | 基盤 1-Q 84 9:00 ~ 12:45 | 基盤 1-Q 85 15:00 ~ 17:00 | | |
| 13.4 配線技術 | | | | | | | | | 理先端-C 85 9:00 ~ 12:00 | 理先端-C 85 13:00 ~ 15:00 |
| 13.5 Si プロセス技術 | | | | | | | 基盤 1-M 85 9:00 ~ 12:45 | 基盤 1-M 86 15:00 ~ 19:00 | 基盤 1-M 86 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-M 86 13:00 ~ 15:00 |
| 13.6 Si デバイス/集積化技術 | | | | | | | 第 1-P7 86 9:30 ~ 11:30 | 第 1-P10 87 15:30 ~ 17:30 | | |
| 13.7 シミュレーション | | | | | | | | | 地域 3-D 88 9:00 ~ 12:15 | |
| 14. 半導体 B (探索的材料・物性・デバイス) | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 1-L 35 13:00 ~ 17:40 | | | | | | | | |
| チュートリアル (ショートコース) | 理 1-B 13 9:00 ~ 12:15 | 理 1-B 13 15:00 ~ 16:30 | | | | | | | | |
| 14.1 探索的材料物性 | | | | | | | | 地域 1-W 88 15:00 ~ 18:15 | 地域 1-W 88 9:00 ~ 12:00 | 地域 1-W 88 13:00 ~ 15:00 |
| 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 | | | | | 第 1-P16 89 15:30 ~ 17:30 | 基盤 1-K 89 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-K * 89 15:00 ~ 17:35 | 基盤 1-K * 89 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-K ** 90 13:00 ~ 15:00 | |
| 14.3 プロセス技術・界面制御 | | | | | 理 1-A 90 9:30 ~ 13:00 | 理 1-A 90 15:00 ~ 18:45 | | | | |
| 14.4 超高速・機能デバイス | | | | | | | 基盤 1-H 90 15:00 ~ 18:15 | 基盤 1-H 91 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-H 91 13:00 ~ 14:15 | |
| 14.5 光物性・発光デバイス | | | | | 第 2-P5 91 9:30 ~ 11:30 | 第 2-P6 92 15:30 ~ 17:30 | | 第 2-P11 92 15:30 ~ 17:30 | | |
| 14.6 化合物太陽電池 | | | 基盤 1-H 92 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-H 93 15:00 ~ 18:15 | 基盤 1-H 93 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-H 93 15:00 ~ 18:15 | 基盤 1-H 94 9:00 ~ 13:00 | | | |
| 15. 結晶工学 | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | | 基盤 3-ZK 35 13:00 ~ 17:00 | | | | | | | | |
| チュートリアル (ショートコース) | | 基盤 3-ZJ 13 15:00 ~ 18:20 | | | | | | | | |
| 15.1 バルク結晶成長 | | | | | | | 第 2-P8 94 9:30 ~ 11:30 | | | |
| 15.2 II-VI 族結晶 | | | | | | | | 基盤 2-ZA 94 15:00 ~ 18:15 | | |
| 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | | | 基盤 2-ZA 95 9:15 ~ 13:00 | 基盤 2-ZA 95 15:00 ~ 18:15 | 基盤 2-ZA 95 9:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZA 95 15:00 ~ 18:45 | 基盤 2-ZA 96 9:00 ~ 13:00 | | | |
| 15.4 III-V 族窒化物結晶 | | | 基盤 2-ZE *** 96 9:00 ~ 12:50 | 基盤 2-ZE 96 15:00 ~ 18:00 | 基盤 2-ZE 97 9:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZE 98 15:00 ~ 19:15 | 基盤 2-ZE 98 9:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZE 98 15:00 ~ 17:45 | 基盤 2-ZE 98 9:00 ~ 12:00 | 基盤 2-ZE 99 13:00 ~ 15:00 |
| 15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 | | | 基盤 2-ZF 97 9:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZF 97 15:00 ~ 18:00 | | | | | | |
| 15.6 IV 族系化合物 | | | 基盤 2-ZB 99 9:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZB 100 15:00 ~ 18:00 | 基盤 2-ZB * 100 9:40 ~ 13:00 | | | | | |
| 15.7 エピタキシーの基礎 | | | | | | | | | 基盤 2-ZA 100 13:00 ~ 14:30 | |
| 15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥 | | | | | | | | | 基盤 2-ZA 100 9:00 ~ 11:15 | |
| 16. 非晶質・微結晶 | | | | | | | | | | |
| 16.1 基礎物性・評価 | | | | | 基盤 3-ZH 100 10:00 ~ 13:00 | 基盤 3-ZH * 101 15:00 ~ 19:00 | | | | |
| 16.2 プロセス技術・デバイス | | | | | | | | | 基盤 3-ZG 101 9:00 ~ 12:00 | 基盤 3-ZG 101 13:00 ~ 14:15 |
| 16.3 シリコン系太陽電池 | | | | | | | 基盤 3-ZH 101 9:45 ~ 13:00 | 基盤 3-ZH 101 15:00 ~ 19:00 | 基盤 3-ZH 102 9:00 ~ 11:45 | |
| 17. ナノカーボン | | | | | | | | | | |
| 関連シンポジウム | 基盤 2-ZE 35 10:20 ~ 16:40 | | | | | | | | | |
| | | 基盤 1-H 35 13:00 ~ 17:00 | | | | | | | | |
| 17.1 成長技術 | | | | | 基盤 2-ZF 102 10:00 ~ 13:00 | 基盤 2-ZF 102 15:00 ~ 19:00 | 基盤 2-ZF 103 9:45 ~ 13:00 | 基盤 2-ZF 103 15:00 ~ 19:00 | 基盤 2-ZF 103 9:00 ~ 12:00 | 基盤 2-ZF 104 13:00 ~ 14:45 |
| 17.2 構造制御・プロセス | | | 人文-ZT 104 9:45 ~ 13:00 | 人文-ZT 104 15:00 ~ 18:00 | | | | | | |
| 17.3 新機能探索・基礎物性評価 | | | | | | | 地域 3-E 104 9:00 ~ 13:00 | 地域 3-E 104 15:00 ~ 18:45 | 地域 3-E 105 9:00 ~ 13:00 | |
| 17.4 デバイス応用 | | | 基盤 3-ZJ 105 9:00 ~ 13:00 | 基盤 3-ZJ * 105 15:00 ~ 18:00 | 基盤 1-K 106 10:00 ~ 13:00 | 基盤 1-K * 106 15:00 ~ 17:00 | | | | |
| 18. 応用物理一般 | | | | | | | | | | |
| 18.1 応用物理一般 | | | | | 地域 1-S 106 9:00 ~ 12:45 | 地域 1-S 106 15:00 ~ 18:00 | | | | |
| 18.2 教育 | | | 第 2-P9 107 9:30 ~ 11:30 | | | | | | | |
| 18.3 新技術 | | | | | | | | | 基盤 3-ZJ 107 9:00 ~ 11:30 | |
| 18.4 トライボロジー | | | | | | | | | 基盤 3-ZJ 107 11:30 ~ 12:00 | |
| 18.5 エネルギー変換・貯蔵 | | | | | | | | 基盤 3-ZM 107 15:00 ~ 16:45 | | |
| 18.6 資源・環境 | | | | | | | | 基盤 3-ZM 107 17:00 ~ 18:15 | | |
| 18.7 総場応用 | | | | | | | | | 基盤 3-ZM 108 9:00 ~ 11:45 | |
| 合同セッション | | | | | | | | | | |
| 合同セッション K 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」 | | | | | 基盤 1-N 108 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-N 108 15:00 ~ 18:00 | 基盤 1-N 108 9:00 ~ 13:00 | 基盤 1-N 109 15:00 ~ 18:00 | 基盤 1-N 109 9:00 ~ 12:00 | 基盤 1-N 109 13:00 ~ 15:00 |
| 合同セッション L (MEMS, NEMS の基礎と応用: 異種機能集積化) | | | 地域 3-E 109 9:00 ~ 13:00 | 地域 3-E 110 15:00 ~ 18:15 | | | | | | |

会場名(アルファベット)の前は、建物を表示
(例: 理 1-B は理学部 1 号館 2 号館の B 会場)
* 応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
* * 分科内招待講演あり。
化合物半導体エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり。
シンポジウムは、12 頁参照。

【建物略称】

理学部 1 号館 →
理学部先端科学実験棟 →
基盤教育棟 1 号館 →
基盤教育棟 2 号館 →
基盤教育棟 3 号館 →

理 1
理先端
基盤 1
基盤 2
基盤 3

地域教育文化学部 1 号館 →
地域教育文化学部 3 号館 →
人文学部 1 号館 →
文翔館 →
第 1 体育館 →
第 2 体育館 →

地域 1
地域 3
人文
文翔
第 1
第 2